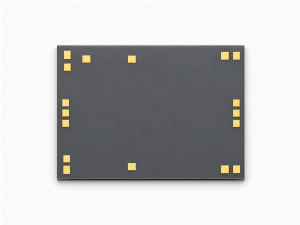
شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC بتردد 13000–15000 MHz



LCI-PA-13000-15000-PS42T شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC تغطي 13000–15000 MHz وتدعم التشغيل المستمر CW والنبضي.

النبضي: PSAT: 42 dBm (نموذجي)؛ كسب القدرة: 21 dB (نموذجي)؛ PAE: 35 % (أدنى) / 37 % (نموذجي). أبعاد الشريحة: 2 × 2.8 × 0.1 mm.

خصائص RF

النبضي؛ TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	13000	-	15000	MHz
قدرة الخرج المشبعة	Psat	-	42	-	dBm
كسب القدرة	Gp	-	21	-	dB
استواء كسب القدرة	ΔGp	-	±0.35	-	dB
كفاءة القدرة المضافة	PAE	35	37	-	%
نسبة VSWR للدخل	VSWR(in)	-	1.8	-	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد المصرف	Vd	24	28	32	V
جهد البوابة	Vg	-5	-3.05	-2.6	V
تيار سكون المصرف	Id	-	0.11	-	A
تيار المصرف الديناميكي	Idd	-	1.7	-	A
تيار البوابة الديناميكي	Igg	-	0.5	-	mA

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	Vd	-	-	32	V
أدنى انحياز للبوابة	Vg	-5	-	-	V
أقصى قدرة دخل	Pin	-	-	24	dBm
درجة حرارة التخزين	TSTG	-65	-	150	°C
أقصى درجة حرارة للقناة	Top	-	-	225	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	2.8 × 2 × 0.1	mm

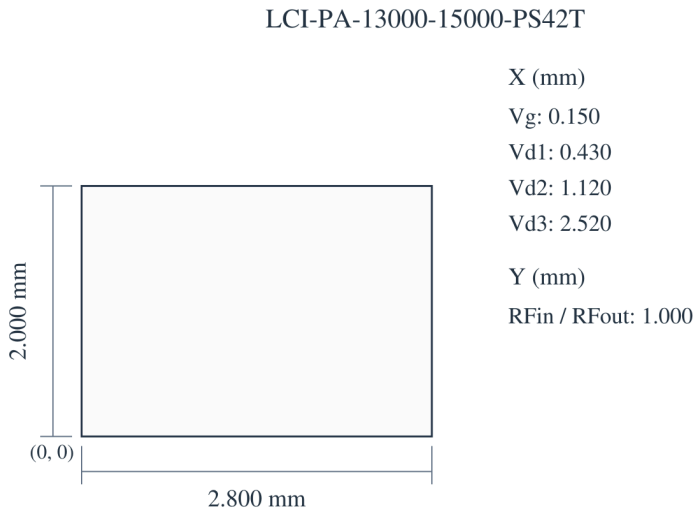
سجل الإصدار الحالي · 2026-11-12 · 1.7. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.6.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز

حجب DC المدمج: RFin / RFout. مسار DC إلى الأرضي: RFin → GND. توصيف بشروط مستقلة: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW; Pin = 21 dBm. طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً. يوصى بتغذية الانحياز من الجانبين.

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي للمحيط الخارجي والإحداثيات المبيّنة، بالأبعاد بوحدة mm. يقتصر استخدامه على الرجوع إلى الأبعاد ولا يحل محل رسم التصنيع أو الربط السلكي الكامل.



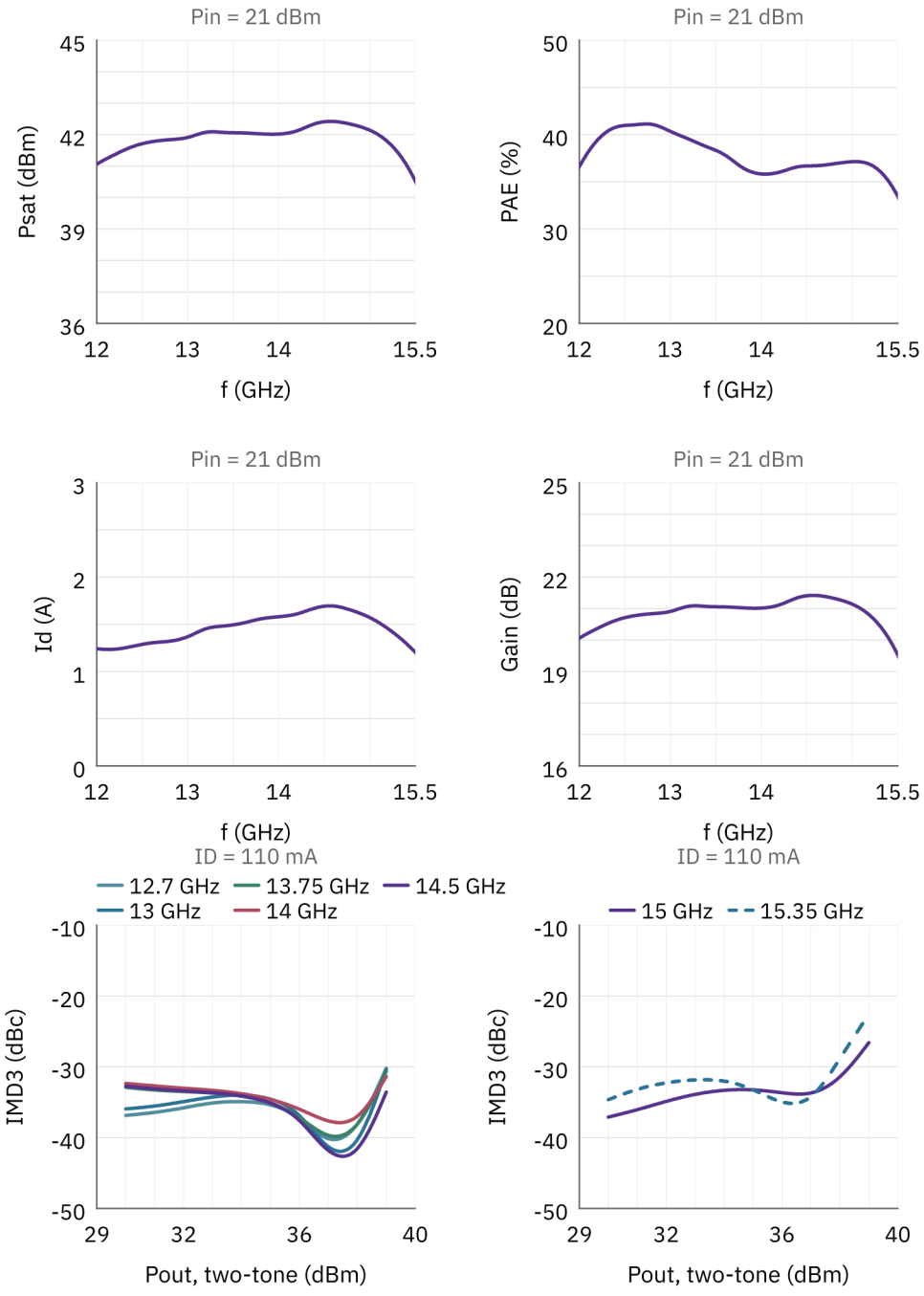
2.800 × 2.000 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

منحنيات الأداء

تُفسَّر كل منحنيات الأداء وفق ظروف التشغيل المبيّنة في الشكل المعني.

قدرة الخرج المشبعة؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كسب القدرة؛ IMD3.

ملاحظات الشكل: Vd=+28V; Vg=-3.05V. القيم المقروءة تقريبية. IMD3: Id = 110 mA. Psat/PAE/Id/Gain: Pin = 21 dBm.



ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.